БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, КОНСТРУКЦІЇ ТА СПОРУДИ

УДК 691.3

Д-р хим. наук А.Н. Плугин, д-р техн. наук А.А. Плугин (УкрГАЖТ), кандидаты техн. наук Ю.Г. Гасан, Е.Н. Червенко (КНУСА)

A.N. Plugin, A.A. Plugin, Yu.G. Gasan, E.N. Chervenko

СТРУКТУРА И ПРОЧНОСТЬ ГИПСОВОГО КАМНЯ: РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРУКТУРЕ

STRUCTURE AND STRENGTH OF GYPSUM: DEVELOPMENT OF IDEAS ABOUT THE STRUCTURE

Постановка проблемы. Продукт гидратации полуводного гипса – двуводный представляет собой гипс высокодисперсную систему с водной дисперсионной средой. В связи с этим прочность и водостойкость определяются, в первую очередь, природой водостойкостью И контактов между его структурными элементами, а затем и самих структурных элементов. Природа указанных контактов остается недостаточно изученной.

Природа контактов между кристаллогидратными частицами двуводного гипса. Согласно существующим представлениям, твердение полуводного гипса протекает по механизму, в соответствии с пересыщенном которым растворе В возникает большое количество зародышей $CaSO_4 \times 2H_2O_1$ которые растут до образующих устойчивых кристаллов, вначале контакты коагуляционного типа и, соответственно, коагуляционную являющуюся пластичной и структуру, малопрочной. Затем возникают фазовые кристаллизационные контакты (рис. 1) [1] и кристаллизационная структура, обеспечивающая прочность гипсового камня.



Рис. 1. Контакты между частицами: а, б – коагуляционные, в – фазовый

В фазовых контактах сцепление частиц обусловлено близкодействующими силами когезии и переход из объема одной частицы в объем другой осуществляется непрерывно внутри одной фазы [1], т.е. возникают контакты срастания.

А.Ф. Полаком дано термодинамическое доказательство возможности контактообразования по такому механизму [2], при котором фазовые контакты срастания образуются за счет перемещения зародышей по поверхности кристалликов $CaSO_4 \times 2H_2O$ зазор между в ними. Достоверность такого механизма кристаллизационного сращивания кристалликов гипса, по мнению автора, основывается на понижении свободной энергии зародыша в зазоре, по сравнению с его положением на поверхности. При этом движущих в качестве факторов перемещения зародышей с поверхности частицы в зазор и образования зародышей контактов рассматривается диффузионное перемещение, а также флуктуация, по Фольмеру, и возникновение молекулярных зародышами связей между противоположных поверхностей в зазоре.

Однако такой механизм не учитывает образования ДЭС поверхности на кристалликов, а, следовательно, энергии ион-ионного притяжения между ПОИ и ПРИ, ион-дипольного притяжения молекул воды к ПОИ (энергия адсорбции молекул воды) и энергии ион-ионного отталкивания между ПРИ в ДЭС. Величины этих энергий намного превышают энергию теплового движения и молекулярного притяжения. Так, энергия теплового движения 1 моля вещества равна 2,435 кДж/моль, а энергия гидратации ПОИ, т.е. связывания воды на поверхности частиц, равна 1641 кДж/моль (для Ca^{2+}), а ион-ионного взаимодействия – больше. Об огромной еше энергии адсорбционного взаимодействия молекул воды с поверхностью свидетельствует и тот факт, что последние молекулы воды удаляются с поверхности твердого тела при температуре около 500-600°С.

Такое преобладание величин энергий ион-ионного и ион-дипольного взаимодействий над энергиями теплового движения и диффузионного перемещения, на наш взгляд, свидетельствует о малой вероятности образования фазовых контактов между кристаллическими частицами двуводного гипса.

Развиваемые нами представления о прочности и водостойкости структуре, гипса, контактах между ее структурными (кристалликами двуводного элементами гипса) основываются на фундаментальных положениях коллоидной химии и физикохимической механики дисперсных систем и материалов, развитых А.Н. Плугиным и А.А. Плугиным с соавт. применительно к вяжущим [3; 4], в том числе гипсу [5]. Основополагающими в них являются представления об электроповерхностных потенциалах простых и сложных веществ [6], латеральном электроповерхностном отталкивании между потенциалопределяющими ионами ПОИ и электроповерхностное давление, обусловленное энергией гидратации. Согласно ИХ этим представлениям, полуводный и двуводный $\psi^0_{\exists\Pi}$ абсолютными гипс обладают электроповерхностными потенциалами. соответственно, полуводный _ 0.21 B. двугидрат – 0,1 В [5].

При контакте гипса с водой под влиянием абсолютного электроповерхностного потенциала происходит разделение зарядов. При этом образуется ДЭС, и равновесные частицы приобретают электроповерхностные потенциалы (при рН7, для собственной среды гипса). Для продольных граней блока $\psi_{\mathcal{H}}^{P} = \psi_{\mathcal{H}}^{0} = 0.1B$, что обусловлено выходом на поверхность грани ДЭС пакетов и отсутствием в них свободной воды [5]. На торцевые грани ДЭС пакетов не выходят, и устанавливается на них равновесный электроповерхностный потенциал

 $\psi_{\mathcal{P}_{II}}^{P} = 0.1B - 0.059 \cdot pH = 0.1 - 0.059 \cdot 7 = -0.31B$

Строение кристаллической решетки двуводного гипса. Двуводный гипс обладает явно выраженной слоистой структурой. Два листа, состоящие из анионных групп $[SO_4]^{2-}$ и тесно связанных с ними катионами Ca^{2+} , слагают двойные слои, между которыми расположены молекулы H_2O , что обусловливает совершенную спайность двуводного гипса

[7]. По [8] слои (пластинчатые пакеты) в структуре $CaSO_4 \times 2H_2O$ формируют цепи $SO_4^{2^-}-Ca^{2^+}-SO_4^{2^-}$, в которых каждый из тетраэдров сульфат-ионов связан через кислородные атомы с двумя катионами Ca^{2^+} (рис. 2). Эти пакеты держатся вместе водородными мостиковыми связями (рис. 3, 4) [8; 9].





Рис. 2. Структура цепи $SO_4^{2^-}-Ca^{2^+}-SO_4^{2^-}$

Рис. 3. Конфигурация водородных мостиковых связей в *CaSO*₄×2*H*₂*O* [8]



Рис. 4. Водородная связь в структуре двуводного гипса [9]

Согласно многочисленным электронно-микроскопическим снимкам ЭМС основными структурными элементами двуводного гипса являются крупные длинные кристаллические частицы призматической формы (рис. 5) длиной до 15 мкм, зачастую образующие параллельные сростки. Дополнительное

увеличение ЭМС (рис. 5) позволило выявить, что крупные призматические кристаллогидраты состоят из маленьких частиц, по форме близких к сферическим. Такие частицы обычно характерны для геля, например, гидросиликатного геля портландцемента. Для уточнения этого на рис. 6 представлен один из характерных ЭМС гидросиликатов кальция с большим увеличением из [10], и на обоих ЭМС (рис. 5, 6) выделены и увеличены фрагменты структуры (светлые рамки, рис. 7, 8) в сопоставимом масштабе.



Рис. 5. ЭМС двуводного гипса [11]



Рис. 6. ЭМС гидросиликатов кальция [10]





Рис. 7. Увеличенный фрагмент (рамка внизу справа) ЭМС рис. 5

Рис. 8. Увеличенный фрагмент ЭМС рис. 6 На фрагменте рис. 7 наименьшие светлые частички имеют размер около 570 Å, а на рис. 8 – около 130 Å. Как видим, размер гелевых частиц гипса существенно превышает размер частиц гидросиликатов кальция.

По аналогии равновесными с размерами кристаллогидратов гипса [5; 12] можно предположить, что равновесный размер этих частиц определяется действием сил (энергии) латерального электроповерхностного отталкивания потенциалопределяющих ионов ПОИ, электроповерхдавления, ностного а также силы притяжения ПОИ к решетке частицы. Сила латерального электроповерхностного следовательно, отталкивания, a, равновесный размер частицы b, в свою очередь, определяются абсолютной величиной равновесного электроповерхностного потенциала $\psi_{2\pi}^{P}$ и расстоянием между ПОИ а₀:

$$b = \frac{4\varepsilon_0 a_0^3}{z^2 e^2} f_{\Pi P}; \qquad (1)$$

$$a_0 = \sqrt{\frac{1}{n}} = \sqrt{\frac{d_1 \cdot z_1 \cdot e}{\varepsilon_1 \varepsilon_0 \varphi_{\Im \Pi}^P}} .$$
 (2)

С учетом этих выражений отношение равновесных размеров частиц гипса и гидросиликатного геля определится выражением

$$\frac{b_{\Gamma H\Pi C}}{b_{\Gamma CK}} = \left(\frac{\psi_{\Im\Pi,\Gamma H\Pi C}^{P}}{\psi_{\Im\Pi,\Gamma CK}^{P}}\right)^{1,5}.$$
 (3)

Подставляя потенциалы $\psi_{\Im\Pi}^{P}$ гипса и низкоосновных гидросиликатов кальция, получим

$$\frac{b_{\rm FHITC}}{b_{\rm FCK}} = \left(\frac{0,22}{0,1}\right)^{1.5} = 3,26,$$

что соответствует действительному отношению размеров этих частиц по данным ЭМС:

$$\frac{b_{\Gamma M\Pi C}}{b_{\Gamma E \Pi b}} = \frac{570}{160} = 3,56.$$

Следовательно, кристаллогидратные призматические блоки двуводного гипса возникают из пересыщенного раствора вначале в виде гелеобразных, близких к сферическим, частиц, равновесный размер которых около 570×10⁻¹⁰ м или 570 Å, из которых затем образуются крупные призматические блоки кристаллогидратов.

кристаллизации Такой механизм гелевые частицы соответствует через данным [13], где показано, что возникновение шарообразных аморфных частиц размером от нескольких сотых мкм до 0,1 мкм – обычное явление при возникновении новой фазы при протекании процесса кристаллизации.

Для визуальной оценки возможности возникновения фазовых контактов между кристалликами $CaSO_4 \times 2H_2O$ ИЗ приведенных ЭМС выбраны и увеличены наиболее наглядные фрагменты в местах контакта кристаллогидратов, в частности фрагмент 1 ЭМС рис. 5 (рис. 9), а также фрагменты 1 и 2 ЭМС рис. 10 (рис. 11). Из фрагментов видно, что фазовые этих контакты между кристаллогидратами не возникают. Видно также, что кристаллики образовывались из дисперсной системы, дисперсная фаза в которой состоит из маленьких гелевых частиц (как отмечалось, около 570 Å) за счет их коагуляции.

На основании выявленных нами структурных единиц – небольших гелевых частиц, слагающих кристаллогидратные развитие частицы (блоки), И В представлений [5] полагаем, что для маленьких частиц величина силы $f_{{\it ЛAT}}^{\, {\it Э\Pi}}$ еще разрушения. недостаточна лля ИХ Определяющим является электроповерхностное давление от энергии гидратации ПОИ $U_{\Gamma.M.}^{\Im\Pi}$. Для проверки этого предположения выполним на основе исходных расчетных положений [5] с учетом энергии гидратации ПОИ



Рис. 9. Увеличенный фрагмент 1 (справа внизу) ЭМС рис. 5

соответствующие расчеты равновесных размеров кристаллогидратных частиц и выявленных нами гелевых частиц и установим критерии их равновесия.



Рис. 10. ЭМС гипса с добавкой хлорида натрия [14]

б)





Рис. 11. Увеличенные фрагменты 1 (слева) и 2 (справа) из ЭМС на рис. 10

Равновесный размер гелевых частиц двуводного гипса и определение условий их роста и растворения. По [3], энергия гидратации ПОИ равна

$$u_{\Gamma.\Pi O M}^{\Im \Pi} = \frac{U_{\Gamma.M}}{2 \cdot N_{A}}, \qquad (4)$$

где $U_{\Gamma.M}$ – энергия гидратации иона Дж/моль; N_A – число Авогадро (9,65×10⁴ 1/моль). По существу, электроповерхностная энергия гидратации ПОИ представляет собой ион-дипольное притяжение между ПОИ и гидратированными им молекулами воды. Соответственно, в поверхностном слое воды возникает электроповерхностное давление, которое передается во все стороны одинаково и, следовательно, в латеральном (вдоль поверхности), а также вдоль ребра направлении. Вырежем мысленно на грани призмы (куба) полосу шириной *a*₀, равной расстоянию между ПОИ, и длиной, равной длине ребра призмы (размеру гелевой частицы). Энергия электроповерхностного давления на поверхности этой полосы равна

$$u_{\Gamma.\Pi OH}^{\Im\Pi} = \frac{U_{\Gamma.H.}}{2 \cdot N_{A} \cdot a_{0}^{2}} \cdot b_{\Gamma E\Pi} \cdot a_{0} = \frac{U_{\Gamma.H.} \cdot b_{\Gamma E\Pi}}{2 \cdot N_{A} \cdot a_{0}}.$$
(5)

Эта давление передается на реберный (угловой) ПОИ Ca^{2+} , стремясь оторвать его от кристаллической решетки, сформированной из элементов $SO_4^{2-}-Ca^{2+}-SO_4^{2-}$ (рис. 12). Отрываясь под влиянием давления, создаваемого электроповерх-

ностной гидратацией ПОИ, реберный ПОИ совершает работу отрыва, равную $f_{\Pi P} \cdot \delta_{Ca^{2+}-SO_4^{2-}}$.

Сила связи ПОИ с ионом SO_4^{2-} :

$$f_{\Pi P} = \frac{z_1 \cdot z_2 \cdot e^2}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon_0 \cdot (\delta_{Ca^{2^+} - SO_4^{2^-}})^2} \cdot 2 \cdot \cos 45^0, \qquad (6)$$

где z_1 и z_2 – валентности ионов ПОИ Ca^{2+} и аниона SO_4^{2+} ; ε и ε_0 – относительная диэлектрическая проницаемость пространства между этими ионами и электрическая

постоянная, 1 и $8,85 \times 10^{-12}$ Ф/м, соотвесттвенно; *е* – элементарный заряд, $1,6 \times 10^{-19}$ Кл.



Рис. 12. Схема действия давления от энергии электроповерхностной гидратации ПОИ $u_{\Gamma.\Pi OH}^{\Im\Pi}$ и работы отрыва реберного ПОИ $f_{\Pi P} \cdot \delta_{Ca^{2+}-SO_{1}^{2-}}$

При этих и ранее вычисленных двум анионам SO_4^{2-} (рис. 12) составит величинах сила притяжения ПОИ Ca^{2+} к

$$f_{\Pi P} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 1.6^2 \cdot 10^{-38}}{4 \cdot 3.14 \cdot 1 \cdot 8.85 \cdot 10^{-12} \cdot 3.77^2 \cdot 10^{-20}} \cdot 2 \cdot 0.707 =$$
$$= \frac{10.24 \cdot 10^{-38}}{1580 \cdot 10^{-32}} \cdot 1.41 = 0.91 \cdot 10^{-8} H,$$

где 2 отражает связь ПОИ Ca^{2+} с двумя анионами SO_4^{2-} .

В изотермических условиях энергия электроповерхностной гидратации переходит в работу отрыва ПОИ

$$u_{\Gamma.\Pi O M}^{\Im \Pi} = f_{\Pi P} \cdot \delta_{Ca^{2+} - SO_4^{2-}}.$$
 (7)

При подстановке в это уравнение выражения (5) для $u_{\Gamma.\Pi O U}^{\Im \Pi}$ оно приобретает вид

$$\frac{U_{\Gamma.M}}{2 \cdot N_A} \cdot \frac{b_{\Gamma E \Pi}}{a_0} = 2f_{\Pi P} \cdot \delta_{Ca^{2+} - SO_4^{2-}}, \quad (8)$$

откуда

$$b_{\Gamma E \Pi} = \frac{4f_{\Pi P} \cdot \delta_{Ca^{2+} - SO_4^{2-}} \cdot N_A \cdot a_0}{U_{\Gamma.M}} . \quad (9)$$

Расстояние между ПОИ на продольной грани двуводного гипса определим по выражению (2):

$$a_{0} = \sqrt{\frac{2,53 \cdot 10^{-10} \cdot 2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{1 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 0,1}} \left(\frac{M \cdot K\pi}{B} = \frac{M \cdot K\pi \cdot M}{K\pi} = M^{2}\right) = \sqrt{\frac{8,096 \cdot 10^{-29}}{0,885 \cdot 10^{-12}}} = \sqrt{9,15 \cdot 10^{-18}} = 96 \cdot 10^{-10} \, \text{m};$$

При энергии гидратации ПОИ (катиона Ca^{2+}) $U_{\Gamma,H}$ = 1641000 Дж/моль [15]

$$b_{\Gamma E \Pi} = \frac{4 \cdot 0.91 \cdot 10^{-8} \cdot 3.77 \cdot 10^{-10} \cdot 6.02 \cdot 10^{23} \cdot 96 \cdot 10^{-10}}{1641000} = \frac{7962 \cdot 10^{-5}}{1.641 \cdot 10^{6}} = 4.85 \cdot 10^{-8} \, \text{M} \approx 500 \text{\AA},$$

что соответствует среднему размеру наименьших частиц на ЭМС рис. 7.

Частица такого размера является равновесной. При $u_{\Gamma.\Pi OH}^{\Im\Pi} \prec f_{\Pi P} \cdot \delta_{Ca^{2+}-SO_4^{2-}}$ частица растет, а при $u_{\Gamma.\Pi OH}^{\Im\Pi} \succ f_{\Pi P} \cdot \delta_{Ca^{2+}-SO_4^{2-}}$ – растворяется.

Равновесный размер кристаллогидратов двуводного гипса и условия его разрушения и растворения. При росте блока и, соответственно, увеличении размеров увеличивается количество ПОИ на его поверхности, а, следовательно, увеличивается сила латерального (вдоль поверхности) электроповерхностного отталкивания между ПОИ $f_{JAT}^{\ \Im \Pi}$. Эта сила передается на реберный ПОИ и реберную гелевую частицу. Но т.к. для равновесной гелевой частицы двуводного гипса энергия электроповерхностной гидратации скомпенсирована работой отрыва реберного ПОИ, движущей силой будет разрушения сила латерального электроповерхностного отталкивания

между ПОИ $f_{ЛАT}^{\ \Im\Pi}$, величина которой, как отмечалось, увеличивается с увеличением размера блока.

Как отмечалось, строение грани призматического блока двуводного гипса формируют цепи $SO_4^{2-}-Ca^{2+}-SO_4^{2-}$. С

учетом этого представлена схема действия силы латерального электроповерхностного отталкивания $f_{ЛAT}^{\ \Im\Pi}$ между ПОИ, действующей на реберный ПОИ или реберную гелевую частицу (рис. 13).



Рис. 13. Уточненная схема действия сил $f_{{\it ЛAT}.{\it E}}^{\,\, {\it Э\Pi}}$ и $f_{{\it \PiP}}$

С учетом этой схемы результирующая сила латерального электроповерхностного отталкивания, действующая на реберный ПОИ, определяется выражением

$$F_{\Lambda AT}^{\Im \Pi} = \frac{z^2 e^2 \cdot b}{4 \varepsilon_0 a_0^3} \cdot \cos 45 \cdot N_{\Pi O \Pi. E \Pi} \quad (10)$$

При увеличении $f_{ЛAT}^{3\Pi}$ сверх определенной величины разрушение блока может происходить как за счет отрыва реберных ПОИ, так и за счет отрыва реберных гелевых частиц в торцевой грани блока, в зависимости от величин силы связи ПОИ с решеткой и частицы с блоком. Сравним эти силы.

Сила притяжения ПОИ к решетке блока определяется выражением

$$F_{\Pi P} = \frac{z^2 \cdot e^2}{4 \cdot \pi \cdot \mathcal{E}_0 \cdot (\delta_{Ca^{2+} - SO_4^{2-}})^2} \cdot 2 \cdot \cos 45^0.$$
(11)

Подставляя соответствующие величины, получим

$$F_{\Pi P} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 1.6^2 \cdot 10^{-38}}{4 \cdot 3.14 \cdot 1 \cdot 8.85 \cdot 10^{-12} \cdot 3.77^2 \cdot 10^{-20}} \cdot 2\cos 45^0 =$$
$$= \frac{10.24 \cdot 10^{-38}}{1580 \cdot 10^{-32}} \cdot 1.41 \left(\frac{K\pi^2}{M^2} = \frac{K\pi \cdot B}{M} = \frac{H \cdot M}{M}\right) = 6.48 \cdot 10^{-9} = 0.91 \cdot 10^{-8} H.$$

Частицы геля связываются друг с другом через слои, в свою очередь связанные через водородные связи – мостики (рис. 3, 4). С учетом этого сила притяжения между этими частицами

$$F_{\Gamma E \Pi} = f_{\Gamma E \Pi} \cdot N_{\Gamma E \Pi} \,. \tag{12}$$

В этом выражении $f_{\Gamma E \Pi}$ – сила, приходящаяся на 1 ПОИ:

$$f_{BC} = \frac{dU_{BC}}{d\delta_{BC} \cdot N_A} = \frac{U_{BC}}{\delta_{BC} \cdot N_A} , \quad (13)$$

а *N*_{ГЕЛ} – количество ПОИ на грани частицы геля (кубической формы):

$$N_{\Gamma E \Pi} = \frac{(b_{\Gamma E \Pi})^2}{a_0^2} \,. \tag{14}$$

При средней величине энергии водородной связи для воды $U_{BC} = 20000 \text{ Дж/моль}$ и ее длине $l_{BC} = 1,75 \text{ Å} = 1,75 \cdot 10^{-10} \text{ м}$

$$f_{BC} = \frac{20000}{1,75 \cdot 10^{-10} \cdot 6,02 \cdot 10^{23}} \left(\frac{\frac{\mathcal{A} \mathcal{H}}{\mathcal{M} O \mathcal{I} \mathcal{B}}}{\mathcal{M} \cdot \frac{1}{\mathcal{M} O \mathcal{I} \mathcal{B}}} = H \right) = 1,9 \cdot 10^{-10} H ,$$

$$N_{\Gamma E \Pi} = \frac{(570 \cdot 10^{-10})^2}{(96 \cdot 10^{-10})} = 35, \ F_{\Gamma E \Pi} = 2 \cdot 1,9 \cdot 10^{-10} \cdot 35 \cdot 2 \cdot \cos 45^0 = 133 \cdot 10^{-10} \cdot 1.41 = 1,88 \cdot 10^{-8} H,$$

что превышает силу связи реберного ПОИ с решеткой блока кристаллогидрата на торцевой грани $(0,91 \times 10^{-8} \text{ H})$. В связи с этим блок в продольном направлении будет разрушаться за счет отрыва реберных ПОИ на торцевой грани, т.е. за счет его растворения, сопровождаясь укорочением.

Подставляя соответствующие величины, из равенства этих силы определены упрощенные выражения для $f_{JAT.E}^{\,\,\,\,\,\,\,}$ продольной и торцевой граней, соответственно:

$$F_{\pi AT}^{\Im \Pi} = 0,000736 \cdot b(H),$$
 (15)

$$f_{JAT}^{\,\,\mathcal{D}\Pi} = 0,00368 \cdot b(H) \,.$$
 (16)

По этим равенствам и величинам F_{ПР} определены поперечный размер двуводного

гипса b = 2500 nm (25000 Å = 2,5 мкм) и продольный b = 12500 nm (1250000 Å = = 12.5 мкм).

Выводы. Установлено, что первичными элементами структуры двуводного гелевые гипса являются частицы, формирующие затем за счет уплотнения кристаллогидратов. блоки Фазовые контакты между частицами не возникают. Прочность и водостойкость обусловлены возникновением между частицами единичных электрогетерогенных контактов типа ПОИ-Н2О-ПОИ (между торцевой и продольной гранями) и типа $Ca^{2+}-H_2O\cdots SO_4^{2-}$ (··· – водородная связь) между продольными гранями частиц кристаллогидратов.

Список литературы

1. Щукин, Е.Д., Коллоидная химия [Текст] / Е.Д. Щукин, А.В. Перцов, Е.А. Амелина. – М: Высшая школа, 2006. – 444 с.

2. Полак, А.Ф. Твердение мономинеральных вяжущих веществ [Текст] / А.Ф. Полак. – М.: Стройиздат, 1966. – 208 с.

3. Плугин, А.Н. Электрогетерогенные взаимодействия при твердении цементных вяжущих [Текст] : дис... докт. хим. наук / А.Н. Плугин. – К.: ИКХХВ, 1989. – 282 с.

4. Плугин, А.А. Долговечность бетона и железобетона в обводненных сооружениях: Коллоидно-химические основы [Текст]: дисс... докт. техн. наук / А.А. Плугин. – Харьков: ХГТУСА, 2005. - 442 с.

5. Плугин, А.Н. Механизм структурообразования и дегидратации гипсовых вяжущих [Текст] / А.Н. Плугин, Х.-Б. Фишер, А.А. Плугин, К.А. Рапина // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. - Харків: УкрДАЗТ, 2010. - Вип. 115. – С. 5-22.

6. О механизме возникновения электроповерхностного потенциала различных веществ в водных растворах [Текст] / А.Н. Плугин, Н.В. Вдовенко, А.И. Бирюков, Ф.Д. Овчаренко // ДАН СССР. – 1988. – Т.298. – №3. – С. 656-661.

7. Бетехтин, А.Г. Курс минералогии [Текст] / А.Г. Бетехтин. – М.: Госгеотехиздат, 1956. – 558 с.

8. Examination of the hygro-mechanical stability of crystalline ... H.-U. Hummel, B. Abdussaljamow, Iphofen, H.-B. Fischer, J. Stark,. Weimar/Germany. www.bauverlag.de/domains/bauverlag/zk.

9. Mandal Pradip K., Mandal Tanuj K. Anion water in gypsum ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) and hemihydrate ($CaSO_4 \cdot 1/2H_2O$) / Cement and Concrete Research. – 32. – 2002. – P. 313-316.

10. Microscopy and Spectroscopy of Stream Rocks with Green Coating caveslime.org/VillaLuz/greenslime/-Microscopy and Spectroscopy of Stream Rocks with Green Coating caveslime.org/VillaLuz/greenslime/-.

11. Рапіна, К.В. Гіпсові самонівелюючі стяжки з фізико-хімічним стоком вологи [Текст]: автореф. дис... канд. техн. наук / К.В. Рапіна. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 20 с.

12. Плугин, А.Н., Коллоидно-химические основы прочности и долговечности бетона и конструкций [Текст] / А.Н. Плугин, А.А. Плугин // Строительные материалы. – 2007. - №7 (631). – С. 68-71.

13. Берестнева, З.Я., Электронно-микроскопическое изучение алюмокремниевых гелей [Текст] / З.Я. Берестнева, Т.А. Корецкая, В.А. Каргин // Колл. журн. – 1955. – Т.17. – № 3. – С. 196-199.

14. Hee Tai Eun, Yong Sig Ko. Preparation of Gypsum Using STS Sludge and Waste Sulfuric Acid Produced in Iron & Steel Industry / Ind. Eng. Chem. - V. 9. - № 5. – 2003. – P. 614-618.

15. Измайлов, Н.А. Электрохимия растворов [Текст] / Н.А. Измайлов. – М.: Химия, 1976. – 488 с.

Ключевые слова: двуводный гипс, структура, кристаллогидраты, контакты.

Аннотации

Виконано критичний аналіз існуючих уявлень про структуру гіпсу, в т.ч. про механізм виникнення фазових контактів зрощення між кристаликами двоводного гіпсу. Показана мала ймовірність утворення таких контактів. Встановлено, що первинними елементами структури двоводного гіпсу є гелеві частинки, що формують потім за рахунок ущільнення блоки кристалогідратів. Визначено рівноважні розміри гелевих частинок і блоків кристалогідратів. Встановлено, що міцність і водостійкість гіпсового каменю обумовлені виникненням між частинками одиничних електрогетерогенних контактів між протилежно зарядженими потенціалвизначальними іонами типу $Ca^{2+}-H_2O-SO_4^{2-}$ між торцевою та поздовжньою

гранями блоків і типу $Ca^{2+}-H_2O\cdots SO_4^{2-}$ (··· – водневий зв'язок) між поздовжніми гранями частинок кристалогідратів.

Выполнен критический анализ существующих представлений о структуре гипса, в т.ч. о механизме возникновения фазовых контактов срастания между кристалликами двуводного гипса. Показана малая вероятность образования таких контактов. Установлено, что первичными элементами структуры двуводного гипса являются гелевые частицы, формирующие затем за счет уплотнения блоки кристаллогидратов. Определены равновесные размеры гелевых частиц и блоков кристаллогидратов. Установлено, что прочность и водостойкость гипсового камня обусловлены возникновением между частицами единичных электрогетерогенных контактов между противоположно заряженными потенциалопределяющими ионами типа $Ca^{2+}-H_2O-SO_4^{2-}$ (торцевой и продольной гранями блоков) и типа $Ca^{2+}-H_2O-SO_4^{2-}$ (торцевой и продольными гранями частиц кристаллогидратов.

A critical analysis of existing ideas about the structure of gypsum, including the mechanism of occurrence of accretion phase contacts between crystals of gypsum dehydrate was made. A low probability of formation of such contacts was shown. Found that the primary elements of the structure of gypsum dihydrate are gel particles that form then due to compression of blocks of crystal. The equilibrium gel particle size and crystalline blocks were defined. Found that the strength and water resistance of gypsum due to the emergence of inter-particle single elektroheterogeneous contacts between oppositely charged potential-ions such as $Ca^{2+}-H_2O-SO_4^{2-}$ (front and longitudinal edges of the blocks) and the type of $Ca^{2+}-H_2O-SO_4^{2-}$ (... – hydrogen communication) between the longitudinal edges of crystalline particles.